

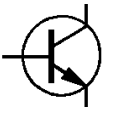
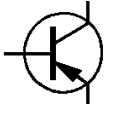
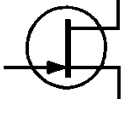
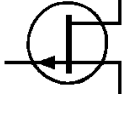
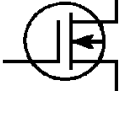
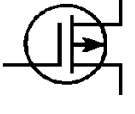
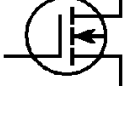
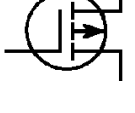
Arbeitsblatt Transistor-Symbole

Zeiche in der folgenden Tabelle in die rechte Spalte die Symbole der Transistoren ohne im Manuskript (außer am Tag vorher!) nachzusehen. Gib außerdem an, welche Polarität die Betriebsspannung U_B und die Steuerspannung U_{st} hat. Die anderen Spalten sind für spätere "Versuche" vorgesehen. Dazu einfach die bereits ausgefüllte(n) Spalte(n) nach hinten umknicken!
Tip: Gehe möglichst NICHT der Reihe nach vor, sondern wähle die Zeilen statistisch aus!

Transistor	3. Versuch	2. Versuch	1. Versuch
npn-Transistor	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
pnp-Transistor	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
n-Kanal J-FET	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
p-Kanal J-FET	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
n-Kanal IG-FET Verarmungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
p-Kanal IG-FET Verarmungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
n-Kanal IG-FET Anreicherungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
p-Kanal IG-FET Anreicherungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$
n-Kanal Dual-Gate IG-FET (Verarmungstyp)	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$

Arbeitsblatt Transistor-Symbole

Zeiche in der folgenden Tabelle in die rechte Spalte die Symbole der Transistoren ohne im Manuskript (außer am Tag vorher!) nachzusehen. Gib außerdem an, welche Polarität die Betriebsspannung U_B und die Steuerspannung U_{st} hat. Die anderen Spalten sind für spätere "Versuche" vorgesehen. Dazu einfach die bereits ausgefüllte(n) Spalte(n) nach hinten umknicken!
Tip: Gehe möglichst NICHT der Reihe nach vor, sondern wähle die Zeilen statistisch aus!

Transistor	3. Versuch	2. Versuch	1. Versuch
npn-Transistor	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = +$ $U_{st} = + 0,7 V$ 
pnp-Transistor	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = -$ $U_{st} = - 0,7 V$ 
n-Kanal J-FET	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = +$ $U_{st} = -$ 
p-Kanal J-FET	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = -$ $U_{st} = +$ 
n-Kanal IG-FET Verarmungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = +$ $U_{st} = -$ 
p-Kanal IG-FET Verarmungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = -$ $U_{st} = +$ 
n-Kanal IG-FET Anreicherungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = +$ $U_{st} = +$ 
p-Kanal IG-FET Anreicherungstyp	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = -$ $U_{st} = -$ 
n-Kanal Dual-Gate IG-FET (Verarmungstyp)	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B =$ $U_{st} =$	$U_B = +$ $U_{st} = -$ 